



人才队伍

[人才队伍](#)
[人才培养](#)
[招聘信息](#)

当前位置: 人才队伍 > 客座教授

客座教授



中村修二

中村修二教授，半导体所客座教授，加州大学圣芭芭拉分校(UCSB)教授，美国国家工程院院士，主要研究方向为氮化物半导体照明。1979年，加入日亚化学公司，1993年发明了GaN基蓝光LED，该发明被誉为世纪发明。随后，中村修二教授还发明了绿光LED、紫外LED、蓝光激光器和绿光激光器，在国际Ⅲ族氮化物及半导体照明领域享有权威、崇高的学术声誉，被誉为蓝光LED之父。获得LED相关授权专利363件，发表高档次论文433篇，其中在《自然》和《科学》发表论文5篇，累计主持项目34项，总项目经费达4.7亿元。研发出新产品3项，已投入市场并批量生产，销售总额达395亿元。近二十年来一直引领着全球半导体照明产业的发展。由于在蓝光LED方面的杰出成就，中村修二教授获得国际奖35项，其中包括仁科纪念奖、IEEE Jack A.莫顿奖、英国兰克奖、富兰克林奖章，还有被誉为“科技界诺贝尔奖”的千禧技术奖等顶级奖。2014年10月7日，赤崎勇、天野浩和中村修二因发明“高效蓝色发光二极管”而获得2014年诺贝尔物理学奖。目前，中村修二教授仍从事氮化镓薄膜技术开发与外延生长研究，研究内容包括GaN基蓝光LED、紫外LED、白光LED及高功率高频高速晶体管等。



地址：广州市天河区长兴路363号

版权所有 (C) 2012 广东省科学院半导体研究所 粤ICP备16052372号

